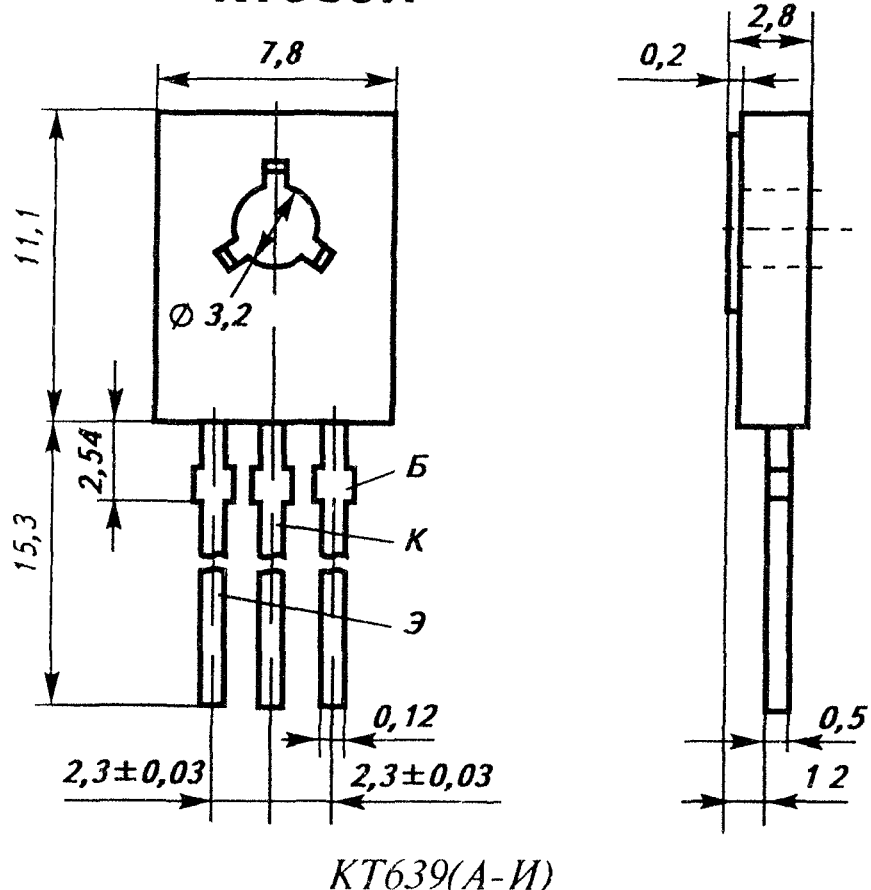


□ **КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639Г, КТ639Д, КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И**



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в каскадах предварительного усиления и в переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзисторов не более 0,7 г.

**Электрические параметры**

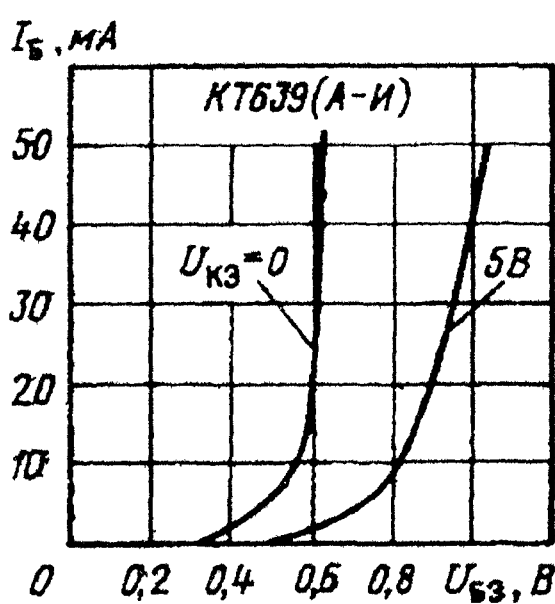
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 2 \text{ В}$ , $I_{э} = 150 \text{ мА}$	
при $T = +25^\circ\text{C}$	
КТ639А, КТ639Г, КТ639Е	40 100
КТ639Б, КТ639Д, КТ639Ж	63 160
КТ639В	100 250
КТ639И	180 400
при $T = +125^\circ\text{C}$	$0,8h_{21э}$ , мин $3h_{21э}$ , макс
при $T = -65^\circ\text{C}$ не менее	$0,3h_{21э}$ , мин
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $I_{э} = 30 \text{ мА}$ , $f = 20 \text{ МГц}$	4 10* 12*
Граничное напряжение при $I_{э} = 50 \text{ мА}$ , не менее	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В	45 В
КТ639Г, КТ639Д	60 В
КТ639Ж	80 В
КТ639И	30 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к} = 500 \text{ мА}$ , $I_{б} = 50 \text{ мА}$	0,15* 0,35* 0,5 Г
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} = 500 \text{ мА}$ , $I_{б} = 50 \text{ мА}$	0,92* 0,96* 1,25 Г
Время рассасывания при $I_{к} = 500 \text{ мА}$ , $I_{б} = 50 \text{ мА}$ , типовое значение	200* нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 \text{ В}$	15* 20* 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5 \text{ В}$	90* 120* 200 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 30 \text{ В}$ , не более	
$T = +25^\circ\text{C}$	100 нА
$T = +125^\circ\text{C}$	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 \text{ В}$ , не более	100 нА

**Предельные эксплуатационные данные**

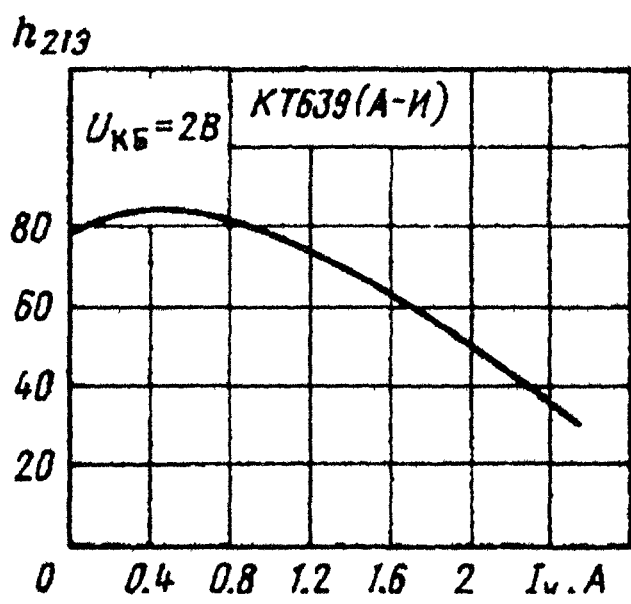
Постоянное напряжение коллектор-база	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В	45 В
КТ639Г, КТ639Д	60 В
КТ639И	30 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1 \text{ кОм}$ для КТ639Ж	100 В
Постоянное напряжение база эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	1,5 А
Импульсный ток коллектора	2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T = -60 \dots +35^\circ\text{C}$	1 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Тепловое сопротивление переход среда	115°C/Вт
Температура окружающей среды	-60 +125°

<sup>1</sup> При  $T > +35^\circ\text{C}$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется выражения

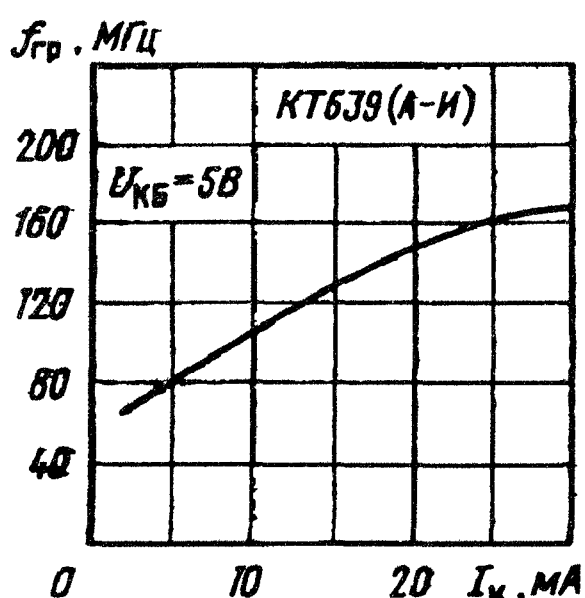
$$P_{к, \text{ макс}} = (150 - T) / 115, \text{ Вт}$$



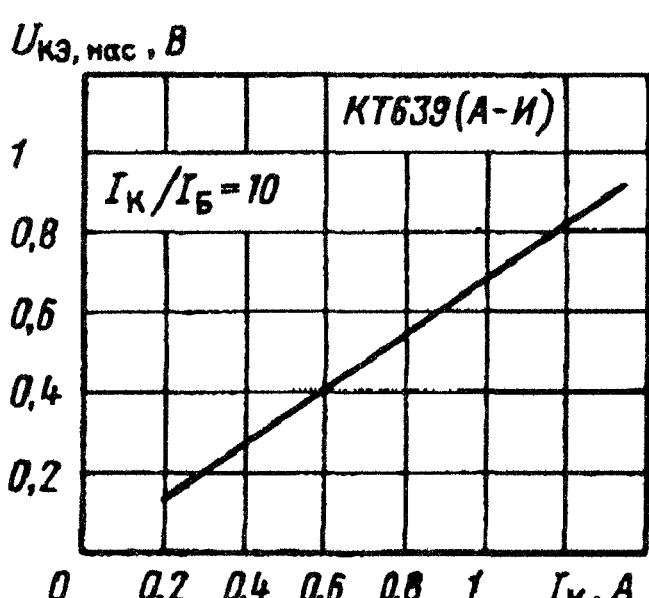
Зависимости тока базы от напряжения база эмиттер



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость граничной частоты от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора